# (19)日本国特許庁 (JP). (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-66382 (P2000-66382A)

(43)公開日 平成12年3月3日(2000.3.3)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
G03F	7/004	501	G03F 7/004	501 2H025
	7/039	601	. 7/039	6 0 1
H01L	21/027		H 0 1 L 21/30	502R

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 21 頁)

	<del></del>		
(21)出願番号	特願平10-236167	(71)出願人	000004178
			ジェイエスアール株式会社
(22)出願日	平成10年8月21日(1998.8.21)		東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	
			東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
			エスアール株式会社内
		(72)発明者	小林 英一
•			東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
			エスアール株式会社内
		(74)代理人	100100985
			弁理士 福沢 俊明

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

# (57)【要約】

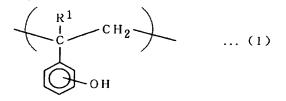
【課題】 特に遠紫外線、X線あるいは電子線に有効に 感応し、基板依存性が小さく、特にTiN、SiNやS iONのような塩基性基板でも裾引きが殆どない、矩形 のパターンを形成でき、しかも感度、解像度等にも優れ た感放射線性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 (イ) p-ヒドロキシスチレン/ (メ タ) アクリル酸 t ーブチル共重合体等で代表される、酸 解離性基を有する共重合体、(ロ)感放射線性酸発生 剤、および(ハ) 水酸基を有する塩基性化合物を含有す ることを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (イ) (I) 下記一般式(1) で表される繰返し単位および下記一般式(2) で表される繰返し単位を含有する共重合体、(ロ) 感放射線性酸発生剤、および(ハ) 水酸基を有する塩基性化合物を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

#### 【化1】



〔一般式 (1) において、 $R^1$  は水素原子またはメチル基を示す。〕

#### 【化2】

$$\begin{array}{c}
 & R^2 \\
 & C \\$$

[一般式 (2) において、 $R^2$  は水素原子またはメチル基を示し、 $R^3$  は t ーブチル基または下記一般式 (3) 【化3】

 $\{-\text{般式}(3)$  において、 $R^4$  および $R^5$  は、相互に独 30 立に水素原子、炭素数  $1\sim 6$  の直鎖状もしくは分岐状の アルキル基または  $5\sim 8$  員環の環状アルキル基を示す か、または相互に結合して一般式 (3) 中の炭素原子と 共に  $5\sim 8$  員環の炭素環構造を形成しており、 $R^6$  および $R^7$  は、相互に独立に水素原子、炭素数  $1\sim 6$  の直鎖 状もしくは分岐状のアルキル基または  $5\sim 8$  員環の環状 アルキル基を示すか、または相互に結合して一般式

(3)中の2個の炭素原子と共に5~8員環の炭素環構造を形成している。}で表される基を示す。]

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物に関わり、さらに詳しくは、特に紫外線、遠紫外線、X線あるいは荷電粒子線の如き放射線を用いる超微細加工に好適なレジストとして有用な感放射線性樹脂組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加 では、発生した酸の触媒作用による化学反応に伴って、 工の分野においては、集積回路のより高い集積度を得る イソブテンガスや炭酸ガスといった気体成分を放出する ために、近年では、サブハーフミクロンオーダー以下の 50 ため、放射線の照射部において体積収縮を生じ、その結

微細加工を再現性よく行なうことができるリソグラフィ 一技術の開発が進められている。従来のリソグラフィー プロセスに使用されている代表的なレジストとしては、 ノボラック樹脂等のアルカリ可溶性樹脂とキノンジアジ ド系感光剤とを用いるポジ型レジストが挙げられ、また 他にネガ型レジストも知られているが、このようなレジ ストは、性能的に限界に達しつつあり、サブハーフミク ロンオーダー以下の微細加工に使用するには、大きな困 難を伴う。例えば、前記ポジ型レジストにおいては、従 10 来から主に使用されている水銀灯のg線(波長436 n m)、i線(波長365nm)等の紫外線を使用するリ ソグラフィープロセスでは、0.35μm以下の微細パ ターンになると、十分な理論焦点深度が達成できないと いう問題がある。そこで、0.35μm以下の微細パタ ーンの形成に際して、より幅広い焦点深度を達成できる 遠紫外線、X線あるいは電子線を使用するリソグラフィ ープロセスの検討が精力的に進められている。しかしな がら、従来のレジストは、遠紫外線、X線あるいは電子 線に対して、パターン形状、感度、コントラスト、現像 20 性等の面で種々の問題がある。即ち、遠紫外線の場合に は、レジストの光吸収が大き過ぎるため、パターン形状 が、ネガ型レジストではパターンの上部より下部が細 い、いわゆる逆テーパー状となりやすく、またポジ型レ ジストでもパターンの上部より下部が太いテーパー状に なり、いずれの場合も矩形のパターンが得られ難いと同 時に、感度、コントラスト等も十分とはいえない。ま た、X線や電子線といったよりエネルギーの高い放射線 の場合には、一般に遠紫外線の場合よりも感度の低下が さらに大きくなり、特にポジ型レジストでは、放射線の 照射により、本来現像液に対する溶解性が上昇すべきと ころが、逆に溶解性が低下してしまうという現象が生じ る場合がある。一方、次世代レジストとして近年注目さ れているものに、感放射線性酸発生剤 (即ち、放射線の 照射により酸を発生する化合物) を含有する化学増幅型 レジストがあり、このレジストは、発生した酸の触媒作 用により、各種放射線に対する感度が高いという利点を 有している。そして、このような化学増幅型レジストと して比較的良好なレジスト性能を示すものに、例えば、 t-ブチルエステル基や t-ブトキシカルボニル基を有 40 する樹脂を用いたもの(例えば、特公平2-27660 号公報参照)、シリル基を有する樹脂を用いたもの(例 えば、特公平3-44290号公報参照)、アクリル酸 成分を含有する樹脂を用いたもの (例えば、特開平4-39665号公報参照) 等が知られているが、これらの 化学増幅型レジストには、それぞれ固有の問題があり、 実用化には種々困難を伴うことが指摘されている。即 ち、tーブトキシカルボニル基を有する樹脂を用いた系 では、発生した酸の触媒作用による化学反応に伴って、 イソブテンガスや炭酸ガスといった気体成分を放出する

果パターン形状が歪みやすく、高精度のパターン形成が 困難であり、またシリル基を有する樹脂を用いた系は、 良好なパターン形成能を有しているが、シリル基をもた ない他のレジストに比べて、基板からの剥離性に劣ると いう難点があり、さらにアクリル酸成分を含有する樹脂 を用いた系では、レジストとシリコン基板との接着性が 不十分であり、また芳香族系樹脂を用いたレジストに比 べて、ドライエッチング耐性も低いという問題がある。 これらの問題を解決する技術として、近年、アクリル酸 エステル構造とフェノール骨格の両者を有する樹脂を用 10 いたレジストが注目を集めている(例えば、特開平4-251259号公報、同5-181279号公報、同5 -113667号公報参照)。しかしながら、このよう なレジストは、アクリル酸系の繰り返し単位のみを有す る樹脂と比較してドライエッチング耐性が改善される利 点があるものの、基板依存性が大きく、特にTiN、S iNやSiONといった塩基性基板では、実際にレジス トパターンを形成すると裾引き形状となり、望ましいと される矩形のパターンが形成されないという欠点があっ た。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、基板 依存性が小さく、特にTiN、SiNやSiONのよう な塩基性基板でも裾引きが殆どない、矩形のパターンを 形成しうる感放射線性樹脂組成物を提供することにあ る。本発明の他の課題は、特に遠紫外線、X線あるいは 電子線に有効に感応し、感度、解像度等に優れた感放射 線性樹脂組成物を提供することにある。

# [0004]

【課題を解決するための手段】本願発明によると、前記 30 課題は、(イ)(I)下記一般式(1)で表される繰返 し単位および下記一般式(2)で表される繰返し単位を 含有する共重合体、(ロ)感放射線性酸発生剤、および (ハ) 水酸基を有する塩基性化合物を含有することを特 徴とする感放射線性樹脂組成物、によって達成される。

# [0005]

# 【化4】

[-般式(1) において、 $R^1$  は水素原子またはメチル 基を示す。〕

# [.0006]

# 【化5】

〔一般式(2)において、R² は水素原子またはメチル 基を示し、R3はtーブチル基または下記一般式(3) [0007]

### 【化6】

{一般式(3)において、R⁴およびR5は、相互に独 立に水素原子、炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の アルキル基または5~8員環の環状アルキル基を示す か、または相互に結合して一般式(3)中の炭素原子と 共に5~8員環の炭素環構造を形成しており、R<sup>6</sup> およ 20 び R7 は、相互に独立に水素原子、炭素数 1~6の直鎖 状もしくは分岐状のアルキル基または5~8員環の環状 アルキル基を示すか、または相互に結合して一般式

(3) 中の2個の炭素原子と共に5~8員環の炭素環構 造を形成している。}で表される基を示す。]

【0008】以下、本発明を詳細に説明する。

### <u>(イ)成分</u>

本発明における(イ)成分は、前記一般式(1)で表さ れる繰返し単位(以下、「繰返し単位(1)」とい う。) および前記一般式(2) で表される繰返し単位 (以下、「繰返し単位(2)」という。)を含有する共 重合体(以下、「共重合体(イ)」という。) からな る。共重合体(イ)は、一般式(1)中のR<sup>1</sup>が水素原 子である繰返し単位(1)とメチル基である繰返し単位 (1) とを同時に含有することができる。R<sup>1</sup> が水素原 子である繰返し単位(1)は、具体的には、o-ヒドロ キシスチレン、m-ヒドロキシスチレンまたはp-ヒド ロキシスチレンの重合性不飽和結合が開裂した繰返し単 位の1種以上からなり、またR¹ がメチル基である繰返 し単位 (1) は、具体的には、o-Eドロキシー $\alpha-\lambda$ 40 チルスチレン、m-ヒドロキシーαーメチルスチレンま たはpーヒドロキシーαーメチルスチレンの重合性不飽 和結合が開裂した繰返し単位の1種以上からなる。共重 合体(イ)における繰返し単位(1)の含有割合は、全 繰返し単位に対して、好ましくは10~90重量%、さ らに好ましくは30~90重量%である。この場合、繰 返し単位(1)の含有割合が10重量%未満であると、 基板との接着性が低下し、レジストパターンの剥がれを 生じるおそれがあり、一方90重量%を越えると、放射 線の照射部と未照射部とのアルカリ現像液に対する溶解

50 速度の差が小さくなり、解像度が低下する傾向がある。

【0009】また、共重合体(イ)は、一般式(2)中のR<sup>2</sup>が水素原子である繰返し単位(2)とメチル基である繰返し単位(2)とを同時に含有することができ、あるいは一般式(2)中のR<sup>3</sup>がtーブチル基である繰返し単位(2)と一般式(3)で表される基である繰返し単位(2)とを同時に含有することができる。一般式(3)において、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>およびR<sup>7</sup>としては、水素原子、炭素数1~3の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基が好ましい。また、R<sup>4</sup>とR<sup>5</sup>が相互に結合した5~8員環の炭素環構造あるいはR<sup>6</sup>とR<sup>7</sup>が相互に結合した5~8員環の炭素環構造としては、シクロペンタン環構造、シクロヘキサン環構造等の5~6員環の炭素環構造が好ましい。一般式(3)で表される基の好ましい具体例としては、下記式(3-1)~(3-5)で表される基を挙げることができる。

[0010]

【化7】

(1, 1-ジメチルー3-オキソブチル基)

[0011]

【化8】

(1, 1-ジエチルー2-メチルー3-オキソペンチル基)

[0012]

【化9】

$$\begin{array}{c|c}
C H_3 & O \\
\hline
C H_3 & O \\
\hline
C H_3 & O \\
\end{array}$$
... (3-3)

 $(1-(2^{\circ}-3)$  ーオキソシクロヘキシル) ー1-3 チルエチル基)

[0013]

【化10】

(1-メチル-1-エチル-3-オキソペンチル基) 【0014】

【化11】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} O \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} C \\ \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} C \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} C$$

(1-(2-オキソプロピル)シクロヘキシル基)

【0015】共重合体(イ)における繰返し単位(2)の含有割合は、全て繰返し単位に対して、好ましくは1~70重量%、さらに好ましくは5~50重量%である。この場合、繰返し単位(2)の含有割合が1重量%未満であると、放射線照射部のアルカリ現像液に対する溶解速度が低くなり、パターンが形成され難くなるおそれがあり、一方70重量%を越えると、共重合体中のベンゼン環の量が少なくなり、ドライエッチング耐性が低下する傾向がある。

【0016】共重合体(イ)は、場合により、繰返し単 位(1)および繰返し単位(2)以外に、ビニル芳香族 化合物、単官能 (メタ) アクリル酸エステル、多官能 (メタ) アクリル酸エステル等を含む群から選ばれる単 量体の重合性不飽和結合が開裂した他の繰返し単位を1 20 種以上含有することができる。前記ビニル芳香族化合物 の具体例としては、スチレン、αーメチルスチレン、ο -メチルスチレン、m-メチルスチレン、p-メチルス チレン、pークロロスチレン等を挙げることができる。 また、前記単官能 (メタ) アクリル酸エステルの具体例 としては、(メタ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリ ル酸エチル、(メタ) アクリル酸 n - プロピル、(メ タ)アクリル酸 i ープロピル、(メタ)アクリル酸 n ー ブチル、(メタ)アクリル酸 i ーブチル、(メタ)アク リル酸sec-ブチル、(メタ) アクリル酸シクロペン 30 チル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシル、(メタ) ア クリル酸ベンジル、 (メタ) アクリル酸フェニル、 (メ タ) アクリル酸テトラシクロデカニル等を挙げることが できる。また、前記多官能(メタ)アクリル酸エステル の具体例としては、エチレングリコールジ (メタ) アク リレート、ジエチレングリコールジ (メタ) アクリレー ト、トリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、 プロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、ジプロ ピレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリプロピ レングリコールジ (メタ) アクリレート、2, 5-ジメ 40 チルー2, 5-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレー ト、2、6-ジメチルー4ーオキソー2、6-ヘプタン ジオールジ (メタ) アクリレート、2-エチルー2-ヒ ドロキシメチルー1、3-プロパンジオールトリ(メ タ) アクリレート等を挙げることができる。共重合体 (イ) における他の繰返し単位の含有割合は、全繰返し 単位に対して、好ましくは60重量%以下、さらに好ま しくは30重量%以下である。

【0017】共重合体(イ)は、例えば、該共重合体中 の各繰返し単位に対応する単量体混合物をラジカル重

50 合、熱重合等により重合することにより製造することが

できる。共重合体(イ)のゲルパーミエーションクロマ トグラフィ (GPC) によるポリスチレン換算重量平均 分子量(以下、「Mw」という。)は、感度、耐熱性、 現像性および解像性を確保する観点から、好ましくは 1,500~500,000、さらに好ましくは3,0 00~300,000である。また、共重合体(イ)の Mwとゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GP C) によるポリスチレン換算数平均分子量(以下、「M n」という。)との比(以下、「Mw/Mn」とい う。)は、感度、耐熱性、現像性および解像性を確保す 10 る観点から、好ましくは1~10、さらに好ましくは 1.0~5.0である。共重合体(イ)は、繰返し単位 (1)、繰返し単位(2)あるいは他の繰返し単位の含 有割合が異なる共重合体の混合物や、Mwおよび/また はMw/Mnの異なる共重合体の混合物として使用する ことができる。共重合体(イ)をこれらの混合物として 使用する場合でも、該混合物を構成している各繰返し単 位の平均含有割合、平均Mwおよび平均Mw/Mnが前 記範囲内にあるのが望ましい。

【0018】本発明においては、共重合体(イ)と共 に、酸解離性を有する他の樹脂(以下、「他の酸解離性 基含有樹脂」という。) を併用することができる。他の 酸解離性基含有樹脂としては、例えば、(1)ポリヒド ロキシ (α-メチル) スチレン中のフェノール性水酸基 の10~60モル%が1-エトキシエトキシ基および/ または1-エトキシプロポキシ基で置換された構造を有 する樹脂(以下、「樹脂 (I)」という。)、 (II) ポ リヒドロキシ (α-メチル) スチレン中のフェノール性 水酸基の10~60モル%がt-ブトキシカルボニルオ キシ基で置換された構造を有する(以下、「樹脂(II) 」という。) 等を挙げることができる。

【0019】樹脂(I)は、ヒドロキシスチレン中のフ ェノール性水酸基の水素原子を1-エトキシエトキシ基 および/または1-エトキシプロポキシ基で置換した繰 返し単位とヒドロキシー αーメチルスチレン中のフェノ ール性水酸基の水素原子を1-エトキシエトキシ基およ び/または1-エトキシプロポキシ基で置換した繰返し 単位とを同時に含有することができる。樹脂(I)の製 造に使用されるヒドロキシ (α-メチル) スチレンは、 具体的には、o-ヒドロキシスチレン、m-ヒドロキシ 40 スチレン、pーヒドロキシスチレン、oーヒドロキシー レンまたはp-ヒドロキシ-α-メチルスチレンの1種 以上からなる。樹脂(I)は、例えば、ポリヒドロキシ (α-メチル) スチレン中のフェノール性水酸基の水素 原子を1-エトキシエトキシ基および/または1-エト キシプロポキシ基で置換する方法、フェノール性水酸基 の水素原子を1-エトキシエトキシ基および/または1 -エトキシプロポキシ基で置換した (α-メチル) スチ

より製造することができる。

【0020】樹脂(1)における1-エトキシエトキシ 基および/または1-エトキシプロポキシ基の置換率 は、好ましくは20~50モル%である。樹脂(1)の Mwは、感度、耐熱性、現像性および解像性を確保する 観点から、好ましくは1,500~500,000、さ らに好ましくは3,000~300,000である。ま た、樹脂(I)のMw/Mnは、感度、耐熱性、現像性 および解像性を確保する観点から、好ましくは1~1 0、さらに好ましくは1.0~5.0である。樹脂 (1) は、1-エトキシエトキシ基および/または1-エトキシプロポキシ基の置換率が異なる樹脂の混合物 や、Mwおよび/またはMw/Mnの異なる樹脂の混合 物として使用することができる。樹脂(1)をこれらの 混合物として使用する場合でも、該混合物の1-エトキ シエトキシ基および/または1-エトキシプロポキシ基 の平均置換率、平均Mwおよび平均Mw/Mnが前記節 囲内にあるのが望ましい。

【0021】また、樹脂 (II) は、ヒドロキシスチレン 中のフェノール性水酸基の水素原子をtーブトキシカル ボニルオキシ基で置換した繰返し単位とヒドロキシ $-\alpha$ ーメチルスチレン中のフェノール性水酸基の水素原子を t ープトキシカルボニルオキシ基で置換した繰返し単位 とを同時に含有することができる。樹脂 (II) の製造に 使用されるヒドロキシ(αーメチル)スチレンは、具体 的には、oーヒドロキシスチレン、mーヒドロキシスチ レン、p-ヒドロキシスチレン、o-ヒドロキシ-α-メチルスチレン、m-ヒドロキシ $-\alpha$ -メチルスチレン またはp-Eドロキシ $-\alpha-$ メチルスチレンの1種以上 からなる。樹脂(II) は、例えば、ポリヒドロキシ ( $\alpha$ 30 ーメチル) スチレン中のフェノール性水酸基の水素原子 をtーブトキシカルボニルオキシ基で置換する方法、フ エノール性水酸基の水素原子を t ーブトキシカルボニル オキシ基で置換した (α-メチル) スチレンをラジカル 重合、熱重合等により重合する方法等により製造するこ とができる。

【0022】樹脂(II)におけるt-ブトキシカルボニ ルオキシ基の置換率は、好ましくは10~40モル%で ある。樹脂(II)のMwは、感度、耐熱性、現像性およ び解像性を確保する観点から、好ましくは1,500~ 500,000、さらに好ましくは3,000~30 0,000である。また、樹脂 (II) のMw/Mnは、 感度、耐熱性、現像性および解像性を確保する観点か ら、好ましくは1~10、さらに好ましくは1.0~ 5. 0 である。樹脂 (II) は、t - ブトキシカルボニル オキシ基の置換率が異なる樹脂の混合物や、Mwおよび /またはMw/Mnの異なる樹脂の混合物として使用す ることができる。樹脂(II)をこれらの混合物として使 用する場合でも、該混合物のt-ブトキシカルボニルオ レンをラジカル重合、熱重合等により重合する方法等に 50 キシ基の平均置換率、平均Mwおよび平均Mw/Mnが

前記範囲内にあるのが望ましい。本発明における他の酸 解離性基含有樹脂の使用量は、共重合体(イ)100重 量部に対して、通常、50重量部以下、好ましくは30 重量部以下である。

#### 【0023】(口)成分

本発明における(ロ)成分は、放射線の照射(以下、 「露光」という。)により酸を発生する感放射線性酸発 生剤(以下、「酸発生剤(ロ)」という。)からなる。 酸発生剤(ロ)としては、■オニウム塩化合物、■スル ホン化合物、■スルホン酸エステル化合物、■スルホン 10 ジフェニルスルホニウム-10-カンファースルホネー イミド化合物、■ジアゾメタン化合物等を挙げることが

できる。以下に、これらの化合物の例を示す。 ■オニウム塩:オニウム塩としては、例えば、ヨードニ ウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウ ム塩、アンモニウム塩、ピリジニウム塩等を挙げること ができる。オニウム塩化合物の具体例としては、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムパーフルオロ ブタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス (4-t-) チルフェニル) ヨードニウムー 2- トリフ 20 ルオロメチルベンゼンスルホネート、ビス (4-t-ブ チルフェニル) ヨードニウムピレンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムドデシルベン ゼンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ョ ードニウムーpートルエンスルホネート、ビス(4-t ーブチルフェニル) ヨードニウムベンゼンスルホネー ト、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム-1 0-カンファースルホネート、ビス (4-t-ブチルフ ェニル) ヨードニウムオクタンスルホネート、ジフェニ エニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、 ジフェニルヨードニウム-2-トリフルオロメチルベン ゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウムピレンスル ホネート、ジフェニルヨードニウムドデシルベンゼンス ルホネート、ジフェニルヨードニウムーpートルエンス ルホネート、ジフェニルョードニウムベンゼンスルホネ ート、ジフェニルヨードニウム-10-カンファースル ホネート、ジフェニルヨードニウムオクタンスルホネー ト、トリフェニルスルホニウムパーフルオロブタンスル ホネート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタ 40 ンスルホネート、トリフェニルスルホニウム-2-トリ フルオロメチルベンゼンスルホネート、トリフェニルス ルホニウムピレンスルホネート、トリフェニルスルホニ ウムドデシルベンゼンスルホネート、トリフェニルスル ホニウムーpートルエンスルホネート、トリフェニルス ルホニウムベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホ ニウム-10-カンファースルホネート、トリフェニル スルホニウムオクタンスルホネート、4-t-ブチルフ エニル・ジフェニルスルホニウムパーフルオロブタンス

ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-t-ブ チルフェニル・ジフェニルスルホニウム-2-トリフル オロメチルベンゼンスルホネート、4-t-ブトキシフ エニル・ジフェニルスルホニウムピレンスルホネート、 4-t-ブトキシフェニル・ジフェニルスルホニウムド デシルベンゼンスルホネート、4-t-ブトキシフェニ ル・ジフェニルスルホニウム-p-トルエンスルホネー ト、4-t-ブトキシフェニル・ジフェニルスルホニウ ムベンゼンスルホネート、4-t-ブトキシフェニル・ ト、4-t-ブトキシフェニル・ジフェニルスルホニウ ムオクタンスルホネート等を挙げることができる。

【0024】■スルホン化合物:スルホン化合物として は、例えば、β-ケトスルホン、β-スルホニルスルホ ン、これらのα-ジアゾ化合物等を挙げることができ る。スルホン化合物の具体例としては、フェナシルフェ ニルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス (フ エニルスルホニル)メタン、4-トリスフェナシルスル ホン等を挙げることができる。

■スルホン酸エステル化合物:スルホン酸エステル化合 物としては、例えば、アルキルスルホン酸エステル、ハ ロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エ ステル、イミノスルホネート等を挙げることができる。 スルホン酸エステル化合物の具体例としては、αーメチ ロールベンゾインパーフルオロブタンスルホネート、 $\alpha$ ーメチロールベンゾイントリフルオロメタンスルホネー ト、α-メチロールベンゾイン-2-トリフルオロメチ ルベンゼンスルホネート、フェナシルフェニルスルホ ン、メシチルフェナシルスルホン、ビス (フェニルスル ルヨードニウムパーフルオロブタンスルホネート、ジフ 30 ホニル)メタン、4-トリスフェナシルスルホン等を挙 げることができる。

> ■スルホンイミド化合物:スルホンイミド化合物として は、例えば、下記式 (4)

[0025]

【化12】

〔式(4)において、Xはアルキレン基、アリーレン 基、アルコキシレン基等の2価の基を示し、R<sup>8</sup> はアル キル基、アリール基、ハロゲン置換アルキル基、ハロゲ ン置換アリール基等の1価の基を示す。) で表される化 合物を挙げることができる。

【0026】スルホンイミド化合物の具体例としては、 N- (トリフルオロメチルスルホニルオキシ) スクシン イミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) ルホネート、4 - t - ブチルフェニル・ジフェニルスル 50 フタルイミド、N - (トリフルオロメチルスルホニルオ

キシ) ジフェニルマレイミド、N- (トリフルオロメチ ルスルホニルオキシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプトー 5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフ ルオロメチルスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ シイミド、N- (トリフルオロメチルスルホニルオキ シ) ビシクロ [2.2.1] ヘプタン-5、6ーオキシ -2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメ チルスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N- (カンフ ァースルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(カンフ 10 ァースルホニルオキシ)フタルイミド、N- (カンファ ースルホニルオキシ) ジフェニルマレイミド、N- (カ ンファースルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] へ プト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファースルホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ [2. 2. 1]  $^{7} ^{-5} ^{-x} ^{-2}$ ,  $^{3} ^{-5} ^{-5} ^{-5} ^{-5} ^{-5}$ シイミド、N- (カンファースルホニルオキシ) ビシク ロ[2.2.1] ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファースルホニルオキ シ) ナフチルイミド、N- (4-メチルフェニルスルホ 20 ニルオキシ) スクシンイミド、N- (4-メチルフェニ ルスルホニルオキシ) フタルイミド、N- (4-メチル フェニルスルホニルオキシ) ジフェニルマレイミド、N - (4-メチルフェニルスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキ シイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキ シ) -7-オキサビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(4-メチル フェニルスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] へ プタン-5,6-オキシ-2,3-ジカルボキシイミ ド、N-(カンファニルスルホニルオキシ) ナフチルイ ミド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルスルホニ ルオキシ)スクシンイミド、N-(2-トリフルオロメ チルフェニルスルホニルオキシ) フタルイミド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルスルホニルオキシ) ジフェニルマレイミド、N-(2-トリフルオロメチル フェニルスルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] へ プトー5-エンー2、3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン 40 -2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオ ロメチルフェニルスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボ キシイミド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルス ルホニルオキシ) ナフチルイミド、N- (4-フルオロ フェニルスルホニルオキシ) スクシンイミド、N- (4 ーフルオロフェニル) フタルイミド、N-(4-フルオ ロフェニルスルホニルオキシ) ジフェニルマレイミド、

N-(4-フルオロフェニルスルホニルオキシ) ビシク

ロ [2.1.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボ 50

キシイミド、N- (4-フルオロフェニルスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ [2.1.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボキシイミド、N- (4-フルオロフェニルスルホニルオキシ) ビシクロ [2.1.1] ヘプタン-5、6-オキシ-2、3-ジカルボキシイミド、N- (4-フルオロフェニルスルホニルオキシ) ナフチルイミド等を挙げることができる。

■ジアゾメタン化合物:ジアゾメタン化合物としては、例えば、下記式 (5)

0 [0027]

【化13】

[式(5)において、R°およびR¹oは、相互に独立に アルキル基、アリール基、ハロゲン置換アルキル基、ハ ロゲン置換アリール基等の1価の基を示す。]で表され る化合物を挙げることができる。

20 【0028】ジアゾメタン化合物の具体例としては、ビス(トリフルオロメチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(ワートルエンスルホニル)ジアゾメタン、メチルスルホニルーpートルエンスルホニルジアゾメタン、ビス(1,1ージメチルエチルスルホニル)ジアゾメタン、シクロヘキシルスルホニル・(1',1'ージメチルエチルスルホニル)ジアゾメタン等を挙げることができる。これらの酸発生剤(ロ)は、単独でもしくは2種類以上混合して使30 用される。

【0029】酸発生剤(ロ)としては、オニウム塩が好 ましく、特に、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨード ニウムパーフルオロブタンスルホネート、ビス (4-t ーブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンス ルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニ ウムーpートルエンスルホネート、ビス (4-t-ブチ ルフェニル) ヨードニウム-10-カンファースルホネ ート、トリフェニルスルホニウムパーフルオロブタンス ルホネート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメ タンスルホネート、トリフェニルスルホニウム-p-ト ルエンスルホネートまたはトリフェニルスルホニウムー 10-カンファースルホネートの少なくとも1種を用い るのが好ましい。本発明における酸発生剤(ロ)の使用 量は、共重合体(イ)100重量部当り、好ましくは 0. 1~20重量部、特に好ましくは0. 5~10重量 部である。この場合、酸発生剤(ロ)の使用量が0.1 重量部未満であると、感度が低下する傾向があり、一方 20重量部を越えると、レジストの塗布性が低下する傾 向がある。

【0030】 (ハ) 成分

本発明における(ハ)成分は、水酸基を有する塩基性化合物(以下、「塩基性化合物(ハ)」という。)からなる。感放射線性酸発生剤を含有する化学増幅型感放射線性樹脂組成物においては、酸拡散制御剤として塩基性物質を添加することにより、パターン形状、パターン上層部における庇の発生防止や、マスク寸法に対する寸法忠実度をより改良できることは既に知られている。本発明者らは、前記共重合体(イ)を樹脂成分とする化学増幅型感放射線性樹脂組成物において、特に基板依存性について鋭意検討した結果、酸拡散制御剤として、塩基性化10合物(ハ)を使用することにより、感放射線性樹脂組成物の諸性能が著しく改善されることを見い出し、本発明を成すに至った。

【0031】本発明における塩基性化合物(ハ)としては、例えば、窒素原子を1個有するアミノ化合物中の炭素原子に結合した水素原子を水酸基で置換した化合物(以下、「塩基性化合物(ハ-1)」という。但し、下記塩基性化合物(ハ-4)を除く。)、窒素原子を2個有するアミノ化合物中の炭素原子に結合した水素原子を水酸基で置換した化合物(以下、「塩基性化合物(ハ-2)」という。)、窒素原子を3個有するアミノ化合物中の炭素原子に結合した水素原子を水酸基で置換した化合物(以下、「塩基性化合物(ハ-3)」という。)、含窒素芳香族複素環化合物中の炭素原子に結合した水素原子を水酸基で置換した化合物(以下、「塩基性化合物(ハ-4)」という。)等を挙げることができる。

20

【0032】以下に、塩基性化合物 (ハ-1) ~ (ハ-4) について具体的に説明する。

塩基性化合物 (ハー1)

塩基性化合物 (ハー1) としては、例えば、下記一般式 30 (6) で表される化合物等を挙げることができる。

[0033]

【化14】

$$R^{11}-N < \begin{cases} R^{12} \\ R^{13} \end{cases}$$
 ... (6)

[一般式 (6) において、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ および $R^{13}$ は、相互に独立に炭素数 $1\sim12$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基または炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基を示すか、または $R^{11}\sim R$  40 13のうちの何れか2つが相互に結合して、一般式 (6) 中の窒素原子と共に $5\sim8$  員環の複素環構造を形成して、 $R^{11}\sim R^{13}$ の残りが炭素数 $1\sim12$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基または炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基を示すか、または $R^{11}$ 、 $R^{12}$ および $R^{13}$ が相互に結合して一般式

(6) 中の窒素原子と共に炭素数6~12のビシクロ環構造を形成しており、かつ前記アルキル基、アリール基、アラルキル基、複素環構造およびビシクロ環構造の少なくとも1つが炭素原子に結合した水酸基を1個以上 50

有する。但し、前記アルキル基、アリール基、アラルキル基、複素環構造およびビシクロ環構造は、それらの任意の炭素 - 炭素結合間に酸素原子、硫黄原子あるいはカルボニル基を有することができ、またそれらの任意の炭素原子に結合した水素原子がアルコキシル基、フェノキシ基等の水酸基以外の1種以上の置換基で置換されていてもよい。〕

【0034】塩基性化合物 (ハー1) の具体例として は、2-ジ-n-プロピルアミノ-1-エタノール、2 ージフェニルアミノー1ーエタノール、2ージベンジル アミノー1ーエタノール、3ージーnープロピルアミノ -1-プロパノール、3-ジ-i-プロピルアミノー1 ープロパノール、3ージフェニルアミノー1ープロパノ ール、3-ジベンジルアミノ-1-プロパノール、2-ジーn-プロピルアミノー1-プロパノール、2-ジー i-プロピルアミノー1-プロパノール、2-ジフェニ ルアミノー1ープロパノール、2ージベンジルアミノー 1-プロパノール、1-ジ-n-プロピルアミノ-2-プロパノール、1-ジーi-プロピルアミノー2-プロ パノール、1-ジフェニルアミノー2-プロパノール、 1-ジベンジルアミノー2-プロパノール、ジメチル・ 4-ヒドロキシフェニルアミン、ジエチル・4-ヒドロ キシフェニルアミン、ジメチル・4ーヒドロキシベンジ ルアミン、ジエチル・4ーヒドロキシベンジルアミン、 【0035】N-(2-ヒドロキシエチル) ピロリジ ン、N-(2-ヒドロキシプロピル) ピロリジン、N-(2-ヒドロキシフェニル) ピロリジン、N-(4-ヒ ドロキシフェニル) ピロリジン、N-(2-ヒドロキシ ベンジル) ピロリジン、N-(4-ヒドロキシベンジ ル) ピロリジン、N-メチル-2-ピロリジノール、N -エチル-2-ピロリジノール、N-メチル-3-ピロ リジノール、N-エチルー3-ピロリジノール、N-フ エニルー3-ピロリジノール、N-ベンジル-3-ピロ リジノール、N-メチル-2-ヒドロキシメチルピロリ ジン、N-エチルー2ーヒドロキシメチルピロリジン、 N-メチルー3-ヒドロキシメチルピロリジン、N-エ チルー3ーヒドロキシメチルピロリジン、N-フェニル -3-ヒドロキシメチルピロリジン、N-ベンジル-3 ーヒドロキシメチルピロリジン、N-メチル-2-(2'-ヒドロキシエチル) ピロリジン、N-エチル-2- (2'-ヒドロキシエチル) ピロリジン、N-メチ ルー3-(2.-ヒドロキシエチル)ピロリジン、N-エチルー3-(2.-ヒドロキシエチル)ピロリジン、 N-フェニル-3- (2'-ヒドロキシエチル) ピロリ ジン、N-ベンジル-3-(2'-ヒドロキシエチル) ピロリジン、N-メチルー2- (2'-ヒドロキシプロ ピル) ピロリジン、N-エチル-2- (2'-ヒドロキ シプロピル) ピロリジン、Nーメチルー3-(2^-ヒ ドロキシプロピル) ピロリジン、N-エチル-3-(2'-ヒドロキシプロピル) ピロリジン、N-フェニ

ルー3-(2'-ヒドロキシプロピル)ピロリジン、N ーベンジルー3ー(2'ーヒドロキシプロピル)ピロリ ジン、

【0036】N-(2-ヒドロキシエチル)ピペリジ ン、N-(2-ヒドロキシプロピル) ピペリジン、N-(2-ヒドロキシフェニル) ピペリジン、N-(2-ヒ ドロキシー4-メチルフェニル) ピペリジン、N- (4 ーヒドロキシフェニル) ピペリジン、N- (2-ヒドロ キシベンジル) ピペリジン、N-(2-ヒドロキシ-4 -メチルベンジル) ピペリジン、N-(4-ヒドロキシ 10 ベンジル) ピペリジン、N-メチル-2-ピペリジノー ル、N-エチル-2-ピペリジノール、N-メチル-3 ーピペリジノール、Nーエチルー3ーピペリジノール、 N-メチルー4-ピペリジノール、N-エチルー4-ピ ペリジノール、N-フェニルー4-ピペリジノール、N ーベンジルー4ーピペリジノール、N-メチルー2ーヒ ドロキシメチルピペリジン、N-エチル-2-ヒドロキ シメチルピペリジン、N-メチル-3-ヒドロキシメチ ルピペリジン、N-エチル-3-ヒドロキシメチルピペ リジン、N-メチル-4-ヒドロキシメチルピペリジ ン、N-エチル-4-ヒドロキシメチルピペリジン、N ーフェニルー4ーヒドロキシメチルピペリジン、Nーベ ンジルー4ーヒドロキシメチルピペリジン、Nーメチル -2-(2'-ヒドロキシエチル)ピペリジン、N-エ チルー2- (2'-ヒドロキシエチル) ピペリジン、N ーメチルー3ー(2'ーヒドロキシエチル)ピペリジ ン、N-エチル-3-(2'-ヒドロキシエチル)ピペ リジン、N-メチル-4-(2'-ヒドロキシエチル) ピペリジン、N-エチル-4-(2'-ヒドロキシエチ シエチル) ピペリジン、N-ベンジル-4-(2'-ヒ ドロキシエチル) ピペリジン、N-メチル-2-(2' ーヒドロキシプロピル) ピペリジン、N-エチルー2-(2'-ヒドロキシプロピル) ピペリジン、N-メチル -3-(2'-ヒドロキシプロピル) ピペリジン、N-エチルー3ー(2'ーヒドロキシプロピル)ピペリジ ン、N-メチル-4-(2'-ヒドロキシプロピル)ピ ペリジン、N-エチル-4-(2'-ヒドロキシプロピ ル) ピペリジン、N-フェニル-4-(2'-ヒドロキ シプロピル) ピペリジン、N-ベンジル-4-(2'-40)ヒドロキシプロピル)ピペリジン、

【0037】N-(2-ヒドロキシエチル) モルホリ ン、N-(2-ヒドロキシプロピル) モルホリン、N-メチルー3-ヒドロキシモルホリン、N-エチル-3-ヒドロキシモルホリン、N-メチル-3-ヒドロキシメ チルモルホリン、N-エチル-3-ヒドロキシメチルモ ルホリン、N-メチル-3-(2'-ヒドロキシエチ ル) モルホリン、トロピン、3-キヌクリジノール等の 水酸基を1個有する化合物;

【0038】メチル・ジエタノールアミン、エチル・ジ 50

エタノールアミン、nープロピル・ジエタノールアミ ン、i-プロピル・ジエタノールアミン、n-ブチル・ ジエタノールアミン、nーペンチル・ジエタノールアミ ン、n-ヘキシル・ジエタノールアミン、n-ヘプチル ・ジエタノールアミン、n-オクチル・ジエタノールア ミン、n-ノニル・ジエタノールアミン、n-デシル・ ジエタノールアミン、n-ウンデシル・ジエタノールア ミン、nードデシル・ジエタノールアミン、フェニル・ ジエタノールアミン、4-メチルフェニル・ジエタノー ルアミン、ベンジル・ジエタノールアミン、4-メチル ベンジル・ジエタノールアミン、メチル・ビス (4-ヒ ドロキシフェニル) アミン、エチル・ビス (4-ヒドロ キシフェニル) アミン、メチル・ビス (4-ヒドロキシ ベンジル) アミン、エチル・ビス (4-ヒドロキシベン ジル)アミン、3ージメチルアミノー1、2ープロパン ジオール、3-ジエチルアミノー1,2-プロパンジオ ール、3-ジ-n-プロピルアミノ-1、2-プロパン ジオール、3-ジーi-プロピルアミノー1, 2-プロ パンジオール、3-ジフェニルアミノ-1, 2-プロパ 20 ンジオール、3-ジベンジルアミノー1, 2-プロパン ジオール、

【0039】3-ピロリジノ-1、2-プロパンジオー ル、N-(2'-ヒドロキシエチル)-3-ヒドロキシ ピロリジン、N-(2'-ヒドロキシプロピル)-3-ヒドロキシピロリジン、N-(2'-ヒドロキシエチ ル) -3-ヒドロキシメチルピロリジン、N-(2'-ヒドロキシプロピル) -3-ヒドロキシメチルピロリジ ン、N-(2'-E) にいっと (2'-E)ドロキシエチル) ピロリジン、N-(2'-ヒドロキシ ル) ピペリジン、N-フェニルー4-(2'-ヒドロキ 30 プロピル) -3-(2'-ヒドロキシエチル) ピロリジン、3-ピペリジノ-1、2-プロパンジオール、N-(2'ーヒドロキシエチル)ー4ーヒドロキシピペリジ ン、N-(2'-ヒドロキシプロピル)-4-ヒドロキ シピペリジン、N-(2'-ヒドロキシエチル)-4-ヒドロキシメチルピペリジン、N-(2'-ヒドロキシ プロピル) -4-ヒドロキシメチルピペリジン、N- · (2'-ヒドロキシエチル)-4-(2'-ヒドロキシ エチル) ピペリジン、N-(2'-ヒドロキシプロピ ル) -4-(2'-ヒドロキシエチル) ピペリジン、N - (2,3-ジヒドロキシプロピル)モルホリン等の水 酸基を2個有する化合物;

> 【0040】トリエタノールアミン、トリー2ープロパ ノールアミン、トリス (4-ヒドロキシフェニル) アミ ン、トリス (4ーヒドロキシベンジル) アミン、N-(2', 3'ージヒドロキシプロピル)ー3ーヒドロキ シピロリジン、N-(2', 3'-ジヒドロキシプロピ ル) -4-ヒドロキシピペリジン、N-(2', 3'-ジヒドロキシプロピル) -3-ヒドロキシピペリジン等 の水酸基を3個有する化合物:

【0041】メチル・ビス(2,3-ジヒドロキシプロ

 $R^{18} - N - R^{19}$  ... (8

ピル) アミン、エチル・ビス (2、3-ジヒドロキシプ ロピル) アミン、n-プロピル・ビス (2、3-ジヒド ロキシプロピル) アミン、i-プロピル・ビス (2, 3 ージヒドロキシプロピル)アミン、フェニル・ビス (2, 3-ジヒドロキシプロピル) アミン、ベンジル・ ビス(2、3-ジヒドロキシプロピル)アミン、2、3 ージヒドロキシプロピル・ビス (2-ヒドロキシエチ ル) アミン、2、3ージヒドロキシプロピル・ビス (2 ーヒドロキシプロピル)アミン、2、3ージヒドロキシ プロピル・ビス (4-ヒドロキシフェニル) アミン、 2、3-ジヒドロキシプロピル・ビス(4-ヒドロキシ ベンジル) アミン、2-ヒドロキシエチル・ビス (2, 3-ジヒドロキシプロピル)アミン、2-ヒドロキシプ ロピル・ビス(2,3-ジヒドロキシプロピル)アミ ン、(2-ヒドロキシ-1, 1-ジヒドロキシメチルエ チル)・ビス(2'ーヒドロキシエチル)アミン、トリ ス(2,3-ジヒドロキシプロピル)アミン等の水酸基 を 4 個以上有する化合物等を挙げることができる。

#### 【0042】塩基性化合物 (ハー2)

塩基性化合物 (ハー2) としては、例えば、下記一般式 20 (7)、一般式 (8) または一般式 (9) で表される化 合物等を挙げることができる。

[0043]

【化15】

$$R^{14} > N - X^1 - N < R^{16} > R^{17}$$
 ... (7)

 $[-般式(7) において、<math>X^1$  は主鎖炭素数が2~8の ポリメチレン鎖を示し、R<sup>14</sup>、R<sup>15</sup>、R<sup>16</sup>およびR 17は、相互に独立に炭素数1~12の直鎖状、分岐状も しくは環状のアルキル基、炭素数6~12のアリール基 または炭素数7~12のアラルキル基を示すか、または R<sup>14</sup>とR<sup>15</sup>が結合し、あるいはR<sup>16</sup>とR<sup>17</sup>が結合して、 それぞれ一般式 (7) 中の1個の窒素原子と共に5~8 員環の複素環構造を形成し、R14~R17の残りが相互に 独立に炭素数1~12の直鎖状、分岐状もしくは環状の アルキル基、炭素数6~12のアリール基または炭素数 7~12のアラルキル基を示し、かつ前記ポリメチレン 鎖、アルキル基、アリール基、アラルキル基および複素 環構造の少なくとも1つが炭素原子に結合した水酸基を 40 1個以上有する。但し、前記ポリメチレン鎖、アルキル 基、アリール基、アラルキル基および複素環構造は、そ れらの任意の炭素ー炭素結合間に酸素原子、硫黄原子あ るいはカルボニル基を有することができ、またそれらの 任意の炭素原子に結合した水素原子がアルコキシル基、 フェノキシ基等の水酸基以外の1種以上の置換基で置換 されていてもよい。}

[0044]

【化16】

[一般式(8)において、R<sup>18</sup>およびR<sup>19</sup>は、相互に独立に炭素数1~12の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、炭素数6~12のアリール基または炭素数7~12のアラルキル基を示し、かつ前記アルキル基、アリール基およびアラルキル基、並びに一般式(8)中のピペラジン環の少なくとも1つが炭素原子に結合した水酸基を1個以上有する。但し、前記アルキル基、アリール基およびアラルキル基は、それらの任意の炭素一炭素結合間に酸素原子、硫黄原子あるいはカルボニル基を有することができ、またそれらの任意の炭素原子に結合した水素原子がアルコキシル基、フェノキシ基等の水酸基以外の1種以上の置換基で置換されていてもよい。〕

[0045]

【化17】

10

$$R^{20} - N \longrightarrow X^2 \longrightarrow N - R^{21}$$
 ... (9)

[一般式(9)において、X<sup>2</sup>は主鎖炭素数が2~8のポリメチレン鎖を示し、R<sup>20</sup>およびR<sup>21</sup>は、相互に独立に炭素数1~12の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、炭素数6~12のアリール基もしくは炭素数7~12のアラルキル基を示し、かつ前記ポリメチレン鎖、アルキル基、アリール基およびアラルキル基、並びに一般式(9)中の1個または2個のピペリジン環の少なくとも1つが炭素原子に結合した水酸基を1個以上有する。但し、前記ポリメチレン鎖、アルキル基、アリール基およびアラルキル基は、それらの任意の炭素一炭素結合間に酸素原子、硫黄原子あるいはカルボニル基を有することができ、またそれらの任意の炭素原子に結合した水素原子がアルコキシル基、フェノキシ基等の水酸基以外の1種以上の置換基で置換されていてもよい。〕

【0046】塩基性化合物(N-2)の具体例としては、N, N, N'-1リメチル-N'-(2-1)には、N, N, N'-1リエチル-N'-(2-1) エチレンジアミン、N, N, N'-1リエチル-N'-(2-1) エチレンジアミン、N, N, N'-1リエチレンジアミン、N, N, N'-1リエチレンジアミン、N, N, N'-1リエチレンジアミン、N, N, N'-1リエチル-N'-(2-1)には、N, N, N'-1リフェニル-N'-(2-1)には、N, N, N'-1リスチレンジアミン、N, N, N'-1リスチレンジアミン、N, N, N'-1リベンジル-N'-(2-1)には、N, N, N'-1リベンジル-N'-(2-1)には、N, N, N'-1リメチル-N'-10(4ーに、N, N, N'-11)エチレンジアミン、N, N, N'-11)エチレンジアミン、N, N, N'-11 エチレンジアミン、N, N, N'-11 エチレンジアミン・N, N, N, N'-11 エチレンジアミン・N, N, N'-11 エチレンジア・N, N, N'-11 エチレンジア・N,

50 【0047】N、N、N'ートリメチルーN'ー(2-

ヒドロキシエチル)トリメチレンジアミン、N,N,  $N' - h \cup \lambda + h - N' - (2 - \iota + \iota + \iota + \iota + \iota + \iota) = 0$ トラメチレンジアミン、N, N, N' -トリメチル-N'-(2-ヒドロキシエチル)ペンタメチレンジアミ ン、N, N, N'ートリメチルーN'ー (2ーヒドロキ シエチル) ヘキサメチレンジアミン、N, N, N' -ト リメチルーN'-(2-ヒドロキシエチル) ヘプタメチ レンジアミン、N, N, N'-トリメチル-N'-(2)ーヒドロキシエチル) オクタメチレンジアミン、1,3 ービス (ジメチルアミノ) -2-プロパノール、1,3 10 ービス(ジエチルアミノ)-2-プロパノール、1-ジ メチルアミノー2ー(3'ーヒドロキシピロリジノ)エ タン、1-ジメチルアミノ-2-(2'-ヒドロキシメ チルピロリジノ) エタン、1ージメチルアミノー2ー {3'-(2''-ヒドロキシエチル) ピロリジノ} エタ ン、1ージメチルアミノー2ー(4'ーヒドロキシピペ リジノ) エタン、

【0048】N-メチル-N'-(2-ヒドロキシエチ ル) ピペラジン、N-n-ブチル-N'- (2-ヒドロ キシエチル) ピペラジン、N-n-ペンチル-N'-(2-ヒドロキシエチル) ピペラジン、N-n-ヘキシ ルーN'-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、Nn-オクチル-N'- (2-ヒドロキシエチル) ピペラ ジン、N-n-デシル-N'- (2-ヒドロキシエチ  $\mu$ ) ピペラジン、N-n-ドデシ $\mu-N'-$ (2-ヒド ロキシエチル) ピペラジン、N-メチル-N'- (2-ヒドロキシプロピル) ピペラジン、N-メチル-N'-(3-ヒドロキシプロピル) ピペラジン、N-フェニル -N'-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、N-ベ ンジル-N'-(2-ヒドロキシエチル) ピペラジン、N-メチル-N'- (4-ヒドロキシフェニル) ピペラ ジン、N-メチル-N'- (4-ヒドロキシベンジル) ピペラジン、

【0049】1-{4'-(N-メチルピペリジニ  $\nu$ ) }  $-2-[4'-{N-(2''-ヒドロキシエチ)}$ ル) ピペリジニル} ] エタン、1 - {4' - (N-n-ドデシルピペリジニル)  $\} - 2 - [4' - \{N - (2')\}]$ ーヒドロキシエチル)ピペリジニル}]エタン、1-{4'-(N-ベンジルピペリジニル)}-2-[4' - {N-(2''-ヒドロキシエチル)ピペリジニル}] エタン、1、3-ビス {4'-(N-メチルピペリジニ ピペリジニル)  $\} -3 - [4' - {N - (2'' - ヒドロ}]$ キシエチル) ピペリジニル} ] プロパン、1-{4'-(2''-ヒドロキシエチル) ピペリジニル}] ヘキサ ン、1 - {4' - (N-メチルピペリジニル)} -8-〔4'-{N-(2''-ヒドロキシエチル) ピペリジニ ル}〕オクタン等の水酸基を1個有する化合物:

ーヒドロキシエチル) エチレンジアミン、N、N' -ジ エチル-N, N'-ビス (2-ヒドロキシエチル) エチ レンジアミン、N, N' -ジメチル-N, N' -ビス (2-EFロキシプロピル) エチレンジアミン、N. N'-ジエチル-N, N'-ビス(2-ヒドロキシプロ ピル) エチレンジアミン、N, N' -ジメチル-N, N'ービス (4-ヒドロキシフェニル) エチレンジアミ ン、N, N' -ジメチル-N, N' -ビス (4-ヒドロ キシベンジル) エチレンジアミン、1, 2-ビス (3) ーヒドロキシピロリジノ) エタン、1、2ービス (3) ーヒドロキシメチルピロリジノ) エタン、1、2ービス タン、1、2-ビス(4'-ヒドロキシピペリジノ)エ タン、1,2-ビス(4'-ヒドロキシメチルピペリジ ノ) エタン、1, 2ービス { (4' − (2''−ヒドロキ) シエチル) ピペリジノ} エタン、1ーモルホリノー2ー {ビス(2'ーヒドロキシエチル) アミノ} エタン 【0051】N, N'ービス(2-ヒドロキシエチル) ピペラジン、N, N' ービス (2-ヒドロキシプロピ 20 ル) ピペラジン、N, N'-ビス (4-ヒドロキシフェ ニル) ピペラジン、N, N'ービス (4-ヒドロキシベ ンジル) ピペラジン、1, 2-ビス [4'- {N-(2''ーヒドロキシエチル)ピペリジニル}]エタン、 1, 2-ビス〔4'- {N-(2''-ヒドロキシプロピ ル) ピペリジニル} ] エタン、1, 2ービス [4' - $\{N-(2''-ヒドロキシエチル) ピペリジニル} \} プ$ ロパン、1, 2-ビス [4'-{N-(2"-ヒドロキ シプロピル) ピペリジニル}〕プロパン等の水酸基を2

【0052】N-メチル-N, N', N'-トリス (2 ーヒドロキシエチル) エチレンジアミン、N-n-ドデ シル-N, N', N'-トリス (2-ヒドロキシエチ ル) エチレンジアミン、N-メチル-N, N', N'-トリス (4ーヒドロキシフェニル) エチレンジアミン、 N-メチル-N, N', N'-トリス (4-ヒドロキシ ベンジル) エチレンジアミン、1-(3'-ヒドロキシ アミノ) エタン、1-(4'-ヒドロキシピペリジノ) -2-{ビス(2'-ヒドロキシエチル)アミノ}エタ 40 ン、

個有する化合物;

【0053】N-(2-ヒドロキシエチル)-N'-(2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピペラジン、N-(2-ヒドロキシプロピル) - N' - (2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピペラジン、N-(4-ヒドロキシフ ェニル) -N'-(2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピペラジン、N-(4-ヒドロキシベンジル)-N'-(2, 3-ジヒドロキシプロピル) ピペラジン、1- $[4' - {N-(2''-ヒドロキシエチル) ピペリジニ$ ル ] ] -2- [4'-{N'-(2'', 3''-ジヒドロ 【0050】N, N'-ジメチルー<math>N, N'-ビス(250 キシプロピル)ピペリジニル}〕 エタン、1- [4'-

 $\{N-(2)'-ヒドロキシエチル)$  ピペリジニル $\}$  ]  $-2-[4'-\{N'-(2)',3''-ジヒドロキシプロピル)$  ピペリジニル $\}$  ] プロパン等の水酸基を3個有する化合物;

【0054】N, N, N', N'-テトラキス (2-ヒ ドロキシエチル) エチレンジアミン、N, N, N'. N'ーテトラキス (2-ヒドロキシプロピル) エチレン ジアミン、N, N, N', N'-テトラキス (4-ヒド ロキシフェニル) エチレンジアミン、N, N, N', N' ーテトラキス (4 - Eドロキシベンジル) エチレン 10ジアミン、N, N, N', N'-テトラキス (2-ヒド ロキシー3-メトキシプロピル) エチレンジアミン、 N, N, N', N'-テトラキス (2-ヒドロキシ-3 -エトキシプロピル) エチレンジアミン、N, N, ロポキシプロピル) エチレンジアミン、N, N, N', N'ーテトラキス(2-ヒドロキシ-3-フェノキシプ ロピル) エチレンジアミン、N, N' -ジメチル-N, N'ービス(2,3-ジヒドロキシプロピル)エチレン ジアミン、N, N' -ジエチル-N, N' -ビス (2, 3-ジヒドロキシプロピル) エチレンジアミン、N-メ チルーN, N', N'-トリス(2', 3'-ジヒドロ キシプロピル) エチレンジアミン、N, N, N', N' ーテトラキス(2,3-ジヒドロキシプロピル)エチレ ンジアミン、N, N'ービス(2, 3-ジヒドロキシプ ロピル) ピペラジン、1, 2-ビス {N-(2', 3' ージヒドロキシプロピル)ピペラジニル}エタン等の4 個以上の水酸基を有する化合物等を挙げることができ

【0055】塩基性化合物 (ハー3)

塩基性化合物(ハー3)としては、例えば、下記一般式

 $R^{27}$   $N-CH_2$   $CH_2 - N < R^{31}$   $R^{32}$  ... (11)

[一般式(11)において、 $R^{27}$ 、 $R^{28}$ 、 $R^{29}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{31}$ および $R^{32}$ は、相互に独立に炭素数 $1\sim 12$ の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、炭素数 $6\sim 12$ のアリール基または炭素数 $7\sim 12$ のアラルキル基を示すか、または $R^{27}$ と $R^{28}$ が相互に結合し、あるいは $R^{29}$ と $R^{30}$ が相互に結合し、あるいは $R^{31}$ と $R^{32}$ が相互に結合し、大名いば $R^{31}$ と $R^{32}$ が相互に結合し、大名いば $R^{31}$ と $R^{32}$ が相互に結合し、大名ので変素原子と共に110年の複数で表現構造を形成し、111年の表もしくは環状のアルキル基、炭素数111年ので変素を表現し、対象数111年のアフラルキル基を示す。111日 前

(10) または一般式(11) で表される化合物等を挙げることができる。

[0056]

【化18】

〔一般式(10)において、X3 およびX4 は、相互に 独立に主鎖炭素数が2~8のポリメチレン鎖を示し、R <sup>22</sup>、R<sup>23</sup>、R<sup>24</sup>、R<sup>25</sup>およびR<sup>26</sup>は、相互に独立に炭素 数1~12の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル 基、炭素数6~12のアリール基または炭素数7~12 のアラルキル基を示すか、またはR22とR23が相互に結 合し、あるいはR<sup>25</sup>とR<sup>26</sup>が相互に結合して、それぞれ 一般式(10)中の1個の窒素原子と共に5~8員環の 複素環構造を形成し、R<sup>22</sup>~R<sup>26</sup>の残りが相互に独立に 炭素数1~12の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキ ル基、炭素数6~12のアリール基または炭素数7~1 2のアラルキル基を示し、かつ前記ポリメチレン鎖、ア ルキル基、アリール基、アラルキル基および複素環構造 の少なくとも1つが炭素原子に結合した水酸基を1個以 上有する。但し、前記ポリメチレン鎖、アルキル基、ア リール基、アラルキル基および複素環構造は、それらの 任意の炭素-炭素結合間に酸素原子、硫黄原子あるいは カルボニル基を有することができ、またそれらの任意の 炭素原子に結合した水素原子がアルコキシル基、フェノ キシ基等の水酸基以外の1種以上の置換基で置換されて いてもよい。〕

[0057]

30 【化19】

40 記アルキル基、アリール基、アラルキル基および複素環構造は、それらの少なくとも1つが炭素原子に結合した水酸基を1個以上有することができ、またそれらの任意の炭素ー炭素結合間に酸素原子、硫黄原子あるいはカルボニル基を有することができ、さらにそれらの任意の炭素原子に結合した水素原子がアルコキシル基、フェノキシ基等の水酸基以外の1種以上の置換基で置換されていてもよい。〕

りが相互に独立に炭素数1~12の直鎖状、分岐状もし 【0058】塩基性化合物(ハー3)の具体例として くは環状のアルキル基、炭素数6~12のアリール基も は、N、N、N'ートリメチルーN'ー{2-(3'-しくは炭素数7~12のアラルキル基を示す。但し、前 50 ヒドロキシピロリジノ)エチル)}エチレンジアミン、

ビス (2-ピロリジノエチル)・2-ヒドロキシエチル アミン、ビス(2-ピロリジノエチル)・2-ヒドロキ シプロピルアミン、メチル・2-ピロリジノエチル・2 N-ジメチル-N'- (2-ピペリジノエチル)-N' -(2-EFD+VX+V) X+VVVY+VX+VN, N'-トリメチル-N'-{2-(4'-ヒドロキ シピペリジノ)エチル) ] エチレンジアミン、

【0059】2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチ ル) フェノール、2、4、6ートリス (ジエチルアミノ 10 メチル) フェノール、2, 4, 6-トリス (ジフェニル アミノメチル)フェノール、2,4,6-トリス(ジベ ンジルアミノメチル) フェノール、2、4、6ートリス (ピロリジノメチル) フェノール、2、4、6ートリス (ピペリジノメチル) フェノール、4-モルホリノメチ ルー2, 6ービス (ジメチルアミノメチル) フェノー ル、2, 4, 6-トリ (モルホリノメチル) フェノール 等の水酸基を1個有する化合物;

【0060】N, N', N''-トリメチル-N, N''-ビス(2-ヒドロキシエチル)ジエチレントリアミン、 N, N, N'', N''-テトラメチル-N'-(2, 3-ジヒドロキシプロピル)ジエチレントリアミン、N-メ ス(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン、メチル ・ビス{2-(3'-ヒドロキシピロリジノ)エチル} アミン、N-メチル-N-(2-ピペリジノエチル)-N', N' –  $\forall$  Z – アミン、メチル・ビス {2-(4'-ヒドロキシピペリ ジノ) エチル} アミン、ビス (2-ピロリジノエチル) ルホリノエチル)・2、3-ジヒドロキシプロピルアミ ン等の水酸基を2個有する化合物;

【0061】N, N''ージメチルーN, N', N''ート リス(2-ヒドロキシエチル)ジエチレントリアミン、  $N-(2-\mathcal{C}_{\mathcal{I}}\mathcal{I})$   $N-(2-\mathcal{C}_{\mathcal{I}}\mathcal{I})$   $N-(2-\mathcal{C}_{\mathcal{I}}\mathcal{I})$ ス (2-ヒドロキシエチル) エチレンジアミン、N-(2-ピペリジノエチル) -N, N', N'-トリス (2-ヒドロキシエチル) エチレンジアミン、2,6-ビス (ジメチルアミノメチル) -4-[{ビス (2'-ヒドロキシエチル) アミノ} メチル] フェノール、4-40 (5)ロキシピロリジノメチル)フェノール、4-(ジメチル アミノメチル) -2, 6-ビス(4'-ヒドロキシピペリジノメチル) フェノール、2、6-ジ (ピロリジノメ チル) -4- [{ビス (2'-ヒドロキシエチル) アミ ノ】メチル〕フェノール、2、6ージ(ピペリジノメチ ル) -4- [{ビス(2'-ヒドロキシエチル) アミ 物;

【0062】N'ーメチルーN、N、N''、N''ーテト 50 フェノール、2、4、6ートリス (4'ーヒドロキシメ

ラキス (2-ヒドロキシエチル) ジエチレントリアミ ン、N'-エチル-N, N, N'', N''-テトラキス (2-ヒドロキシエチル) ジエチレントリアミン、N' ヒドロキシエチル) ジエチレントリアミン、N'-n-ヘキシル-N, N, N'', N''-テトラキス (2-ヒド ロキシエチル) ジエチレントリアミン、N'-n-オク チル-N, N, N'', N''-テトラキス (2-ヒドロキ シエチル) ジエチレントリアミン、N'-n-デシルー N, N, N'', N''-テトラキス (2-ヒドロキシエチ ル) ジエチレントリアミン、N'-n-ドデシル-N, N, N'', N''-Fジエチレントリアミン、N'-フェニルーN, N, N'', N''-テトラキス (2-ヒドロキシエチル) ジエ チレントリアミン、N'ーベンジル-N, N, N'', N''-テトラキス (2-ヒドロキシエチル) ジエチレン トリアミン、

【0063】N, N, N', N'', N''ーペンタキス (2-ヒドロキシエチル) ジエチレントリアミン、N, 20 N, N', N'', N''ーペンタキス (2-ヒドロキシプ ロピル) ジエチレントリアミン、N, N, N', N'', N''ーペンタキス (4-ヒドロキシフェニル) ジェチレントリアミン、N, N, N', N'', N''ーペンタキス (4-ヒドロキシベンジル) ジエチレントリアミン、 N, N, N', N'', N''-ペンタキス (2-ヒドロキ シー3ーメトキシプロピル)ジエチレントリアミン、 N, N, N', N'', N''-ペンタキス (2-ヒドロキ シー3-エトキシプロピル) ジエチレントリアミン、 N, N, N', N'', N''-ペンタキス (2-ヒドロキ  $\cdot 2$ , 3-ジヒドロキシプロピルアミン、ビス(2-モ 30 シー3-nープロポキシプロピル)ジエチレントリアミ ン、N, N, N', N'', N''-ペンタキス (2-ヒド ロキシー3-フェノキシプロピル) ジエチレントリアミ ン、N, N''-ジメチル-N, N', N''-トリス (2, 3-ジヒドロキシプロピル) ジエチレントリアミ ン、N'ーメチルーN, N, N'', N''ーテトラキス (2, 3-ジヒドロキシプロピル)ジエチレントリアミ ン、N, N, N', N'', N''-ペンタキス (2, 3-ジヒドロキシプロピル) ジエチレントリアミン、

【0064】4ージメチルアミノメチルー2、6ービス [{ビス(2'ーヒドロキシエチル)アミノ}メチル] フェノール、2、4、6ートリス〔{ビス(2ーヒドロ キシエチル) アミノ} メチル] フェノール、2、4、6 ートリス〔{ビス(2ーヒドロキシプロピル)アミノ} メチル] フェノール、2、4、6-トリス(3'-ヒド ロキシピロリジノメチル)フェノール、2、4、6ート リス(3'-ヒドロキシメチルピロリジノメチル)フェ ノール、2、4、6ートリス [{3'-(2''-ヒドロ キシエチル) ピロリジノ} メチル] フェノール、2、 4,6-トリス(4'-ヒドロキシピペリジノメチル)

チルピペリジノメチル)フェノール、2、4、6ートリ ス [ $\{4' - (2'' - ヒドロキシエチル) ピペリジノ\}$ メチル〕フェノール等の水酸基を4個以上有する化合物 等を挙げることができる。

# 【0065】塩基性化合物 (ハー4)

塩基性化合物 (ハー4) としては、例えば、下記一般式 (12) で表される化合物等を挙げることができる。

[0066]

【化20】

$$R^{33}$$
  $R^{34}$   $R^{35}$   $R^{36}$  ... (12)

〔一般式 (12) において、R<sup>33</sup>、R<sup>34</sup>、R<sup>35</sup>、R<sup>36</sup>お よびR<sup>37</sup>は、相互に独立に水素原子、水酸基、炭素数1 ~12の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、炭 素数6~12のアリール基または炭素数7~12のアラ ルキル基を示すか、またはR33とR34が相互に結合し、 36が相互に結合し、あるいはR36とR37が相互に結合し て、それぞれ一般式(12)中の2個の炭素原子と共に 6員環の芳香環構造を形成し、R33~R37の残りが相互 に独立に水素原子、水酸基、炭素数1~12の直鎖状、 分岐状もしくは環状のアルキル基、炭素数6~12のア リール基または炭素数7~12のアラルキル基を示し、 かつR33~R37の少なくとも1つが水酸基であるか、あ るいは前記アルキル基、アリール基、アラルキル基およ び芳香環構造の少なくとも1つが炭素原子に結合した水 酸基を1個以上有する。但し、R<sup>33</sup>~R<sup>37</sup>の少なくとも 1つが水酸基であるとき、残りのR33~R37の前記アル キル基、アリール基、アラルキル基および芳香環構造の 少なくとも1つも水酸基を1個以上有することができ、 前記アルキル基、アリール基、アラルキル基および芳香 環構造は、それらの任意の炭素-炭素結合間に酸素原 子、硫黄原子あるいはカルボニル基を有することがで き、またそれらの任意の炭素原子に結合した水素原子が アルコキシル基、フェノキシ基、ピリジル基等の水酸基 以外の1種以上の置換基で置換されていてもよい。]

【0067】塩基性化合物(ハー4)の具体例として は、2-ヒドロキシピリジン、3-ヒドロキシピリジ ン、4-ヒドロキシピリジン、2-ヒドロキシー3-メ チルピリジン、2-ヒドロキシ-4-メチルピリジン、 2-ヒドロキシー5-メチルピリジン、2-ヒドロキシ -6-メチルピリジン、3-ヒドロキシ-2-メチルピ リジン、3-ヒドロキシ-4-メチルピリジン、3-ヒ ドロキシー5-メチルピリジン、3-ヒドロキシー6-メチルピリジン、4ーヒドロキシー2ーメチルピリジ ン、4-ヒドロキシー3-メチルピリジン、2-ヒドロ キシー4ーエチルピリジン、2ーヒドロキシー4ーnー 50 ル、2ー (4ーピリジル) -1, 3ープロパンジオー

プロピルピリジン、2-ヒドロキシ-4-i-プロピル ピリジン、2-ヒドロキシ-4-n-ブチルピリジン、 2-ヒドロキシー4-n-ドデシルピリジン、2-ヒド ロキシー4-フェニルピリジン、2-ヒドロキシー4-ベンジルピリジン、2-ヒドロキシメチルピリジン、3 ーヒドロキシメチルピリジン、4ーヒドロキシメチルピ リジン、2-(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、3 - (2'-ヒドロキシエチル) ピリジン、4-(2'-ヒドロキシエチル) ピリジン、2-(2'-ヒドロキシ 10 プロピル) ピリジン、3-(2'-ヒドロキシプロピ ル) ピリジン、4-(2'-ヒドロキシプロピル) ピリ ジン、4-(4'-ヒドロキシフェニル)ピリジン、4 - (4'-ヒドロキシベンジル)ピリジン、2ーキノリ ノール、3-キノリノール、4-キノリノール、1-イ ソキノリノール、3-イソキノリノール、4-イソキノ リノール、αーピリドイン等の水酸基を1個有する化合

【0068】2、3ージヒドロキシピリジン、2、4ー ジヒドロキシピリジン、2、5-ジヒドロキシピリジ あるいは $R^{34}$ と $R^{35}$ が相互に結合し、あるいは $R^{35}$ とR 20 ン、2、6 - ジヒドロキシピリジン、3、4 - ジヒドロ キシピリジン、3、5-ジヒドロキシピリジン、2-ヒ ドロキシー3ーヒドロキシメチルピリジン、2ーヒドロ キシー4ーヒドロキシメチルピリジン、2ーヒドロキシ -5-ヒドロキシメチルピリジン、2-ヒドロキシ-6 ーヒドロキシメチルピリジン、3-ヒドロキシ-4-ヒ ドロキシメチルピリジン、3-ヒドロキシ-5-ヒドロ キシメチルピリジン、2-ヒドロキシ-3-(2'-ヒ ドロキシエチル) ピリジン、2-ヒドロキシ-4-(2'ーヒドロキシエチル) ピリジン、2ーヒドロキシ 30 -5-(2'-ヒドロキシエチル) ピリジン、2-ヒド ロキシー6-(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、3 ーヒドロキシー4ー(2'ーヒドロキシエチル)ピリジ ン、3-ヒドロキシ-5-(2'-ヒドロキシエチル) ピリジン、2, 3-ジ(ヒドロキシメチル)ピリジン、 2, 4-ジ (ヒドロキシメチル) ピリジン、2, 5-ジ (ヒドロキシメチル) ピリジン、2,6-ジ(ヒドロキ シメチル)ピリジン、3、4-ジ(ヒドロキシメチル) ピリジン、3,5-ジ(ヒドロキシメチル)ピリジン、 2, 3-ビス(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、 40 2, 4ービス (2'ーヒドロキシエチル) ピリジン、 2, 5ービス(2'ーヒドロキシエチル) ピリジン、 2, 6-ビス(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、 3, 4ービス(2'ーヒドロキシエチル)ピリジン、 3, 5ービス(2'ーヒドロキシエチル)ピリジン 【0069】3-(2-ピリジル)-1, 2-プロパンジオール、3-(3-ピリジル)-1, 2-プロパンジ オール、3-(4-ピリジル)-1,2-プロパンジオ ール、2-(2-ピリジル)-1、3-プロパンジオー  $\nu$ 、2-(3-ピリジル)-1、3-プロパンジオー

ル、2-(2-ピリジル)-1, 4-ブタンジオール、2-(3-ピリジル)-1, 4-ブタンジオール、2-(4-ピリジル)-1, 4-ブタンジオール、2-(2-ピリジル)-2, 3-ブタンジオール、2-(3-ピリジル)-2, 3-ブタンジオール、2-(4-ピリジル)-2, 3-ブタンジオール, 2-(4-ピリジル)-1, 4-ブタンジオール, 2, 3-ジ(2-ピリジル)-1, 4-ブタンジオール, 2, 3-ジ(4-ピリジル)-1, 4-ブタンジオール, 2, 3-ジ(2-ピリジル)-1, 4-ブタンジオール, 2, 3-ジ(2-ピリジル)-1, 4-ブタンジオール, 2, 3-ジ(2-ピリジル)-2, 3-ブタンジオール, 2, 3-ジ(3-ピリジル)-2, 3-ブタンジオール, 2, 3-ジ(4-ピリジル)-2, 3-ブタンジオール, 2, 3-ジ(4-ピリジル)-2, 3-ブタンジオール等の水酸基を 2 個有する化合物;

【0070】2,6-ジヒドロキシー4-ヒドロキシメチルピリジン、3,5-ジヒドロキシー4-ヒドロキシメチルピリジン、2,6-ジヒドロキシー4-(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、3,5-ジヒドロキシー4-(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、4-ヒドロキシー2,6-ジ(ヒドロキシメチル)ピリジン、4-ヒドロキシー3,5-ジ(ヒドロキシー3,5-ビスエチル)ピリジン、4-ヒドロキシー2,6-ビス(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、4-ヒドロキシー3,5-ビス(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、2,4,6-トリ(ヒドロキシメチル)ピリジン、3,4,5-トリ(ヒドロキシメチル)ピリジン、2,4,6-トリス(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、3,4,5-トリス(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、3,4,5-トリス(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン、3,4,5-トリス(2'-ヒドロキシエチル)ピリジン等の水酸基を3個有する化合物等を挙げることができる。

【0071】本発明において、塩基性化合物(ハ)とし ては、前記塩基性化合物 (n-1) ~ (n-4) のう ち、塩基性化合物(ハー1)、塩基性化合物(ハー2) および塩基性化合物(ハー3)が好ましく、さらに好ま しくは、窒素原子と水酸基の間に炭素原子を2個有する 塩基性化合物 (ハー1)、窒素原子と水酸基の間に炭素 原子を2個有する塩基性化合物(ハー2)および窒素原 子と水酸基の間に炭素原子を2個有する塩基性化合物 (ハー3)であり、また塩基性化合物(ハ)中の水酸基 の数は、1~(窒素原子数×3)が好ましく、特に好ま しくは $1\sim$  (窒素原子数 $\times$ 2+1) である。本発明にお ける塩基性化合物(ハ)としては、特に、トリエタノー 40 ルアミン、N-(2-ヒドロキシエチル) ピペリジン、 N, N'ービス(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、 1, 2-ビス〔4'-{N-(2''-ヒドロキシエチ ル) ピペリジニル} ] プロパン、N, N, N', N'-\*

【0072】本発明において、塩基性化合物(ハ)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。本発明において、塩基性化合物(ハ)の使用量は、共重合体(イ)100重量部当り、好ましくは0.01~1重量部、特に好ましくは0.02~0.5重量部である。塩基性化合物(ハ)の使用量を前記範囲内とすることにより、高感度となり、基板の種類に係わらず矩形のレジストパターンを得ることができる。

【0073】また、本発明の感放射線性樹脂組成物に ) は、場合により、下記する溶解制御剤を配合するすることができる。

### 溶解制御剤

溶解制御剤は、感放射線性樹脂組成物のアルカリ可溶性 を制御する性質を有し、酸の存在下で解離、例えば加水 分解させることにより、感放射線性樹脂組成物のアルカ リ溶解性制御効果を低下もしくは消失させる作用を有す るか、または感放射線性樹脂組成物のアルカリ溶解性を 促進させる作用を有する化合物である。このような溶解 制御剤としては、例えば、フェノール性水酸基、カルボ 30 キシル基等の酸性官能基中の水素原子を酸解離性基で置 換した化合物等を挙げることができる。溶解制御剤は、 低分子化合物でも高分子化合物でもよいが、好ましい溶 解制御剤としては、ビスフェノールA、ビスフェノール F、ビスフェノールSや、1、1ービス(4'ーヒドロ キシフェニル) -1- [4' - {1''-メチル-1''-(4''' ーヒドロキシフェニル) エチル} フェニル] エ タン等の多価フェノール性化合物、あるいは4-ヒドロ キシフェニル酢酸等のカルボン酸化合物の酸性官能基中 の水素原子を酸解離性基で置換した化合物等を挙げるこ とができる。好ましい低分子化合物の溶解制御剤の具体 例としては、下記構造式(13)または構造式(14) で示される化合物を挙げることができる。

【0074】 【化21】

$$(H_3C)_3C - O - C - O - C - O - C + 3$$

... (14)

【0076】また、高分子の溶解制御剤としては、前記 共重合体(イ)や他の酸解離性基含有樹脂以外の酸解離 性基含有樹脂(以下、「溶解制御性樹脂」という。)を 20 使用することができる。ここで酸解離性基とは、酸の存 在下で解離して、溶解制御剤に対してアルカリ可溶性を 発現する置換基を意味する。このような酸解離性基とし ては、例えば、置換メチル基、1-置換エチル基、1-分岐アルキル基、シリル基、ゲルミル基、アルコキシカ ルボニル基、アシル基、環式酸解離性基等を挙げること ができる。前記置換メチル基としては、例えば、メトキ シメチル基、メチルチオメチル基、エトキシメチル基、 エチルチオメチル基、2-メトキシエトキシメチル基、 ロプロピルメチル基、ベンジル基、pーブロモベンジル 基、p-ニトロベンジル基、p-メトキシベンジル基、 p-メチルチオベンジル基、p-エトキシベンジル基、 p-エチルチオベンジル基、ジフェニルメチル基、トリ フェニルメチル基、ピペロニル基等を挙げることができ る。前記1-置換エチル基としては、例えば、1-メト キシエチル基、1-メチルチオエチル基、1、1-ジメ トキシエチル基、1-エトキシエチル基、1-エチルチ オエチル基、1,1-ジエトキシエチル基、1-フェノ キシエチル基、1-フェニルチオエチル基、1,1-ジ 40 フェノキシエチル基、1-ベンジルオキシエチル基、1 - ベンジルチオエチル基、1 - シクロプロピルエチル 基、1-フェニルエチル基、1、1-ジフェニルエチル 基、αーメチルフェナシル基等を挙げることができる。 前記1-分岐アルキル基としては、例えば、i-プロピ ル基、secーブチル基、tーブチル基(但し、溶解制 御性樹脂の場合は除く。)、1,1-ジメチルプロピル 基、1-メチルブチル基、1、1-ジメチルブチル基等 を挙げることができる。

ルシリル基、ジメチル・エチルシリル基、メチル・ジエ チルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチル・i-プ ロピルシリル基、メチル・ジーiープロピルシリル基、 トリーi-プロピルシリル基、ジメチル・t-ブチルシ リル基、メチル・ジー t ーブチルシリル基、トリー t ー ブチルシリル基、ジメチル・フェニルシリル基、メチル ・ジフェニルシリル基、トリフェニルシリル基等を挙げ ることができる。前記ゲルミル基としては、例えば、ト リメチルゲルミル基、ジメチル・エチルゲルミル基、メ チル・ジエチルゲルミル基、トリエチルゲルミル基、ジ メチル・i-プロピルゲルミル基、メチル・ジーi-プ ロピルゲルミル基、トリーiープロピルゲルミル基、ジ ベンジルオキシメチル基、ベンジルチオメチル基、シク 30 メチル・tーブチルゲルミル基、メチル・ジーtーブチ ルゲルミル基、トリーt-ブチルゲルミル基、ジメチル ・フェニルゲルミル基、メチル・ジフェニルゲルミル 基、トリフェニルゲルミル基等を挙げることができる。 【0078】前記アルコキシカルボニル基としては、例 えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、 i ープロポキシカルボニル基、t ーブトキシカルボニル 基、t-ペンチルオキシカルボニル基等を挙げることが できる。前記アシル基としては、例えば、アセチル基、 プロピオニル基、ブチリル基、ヘプタノイル基、ヘキサ ノイル基、バレリル基、ピバロイル基、イソバレリル 基、ラウリロイル基、ミリストイル基、パルミトイル 基、ステアロイル基、オキサリル基、マロニル基、スク シニル基、グルタリル基、アジポイル基、ピペロイル 基、スベロイル基、アゼラオイル基、セバコイル基、ア クリロイル基、プロピオロイル基、メタクリロイル基、 クロトノイル基、オレオイル基、マレオイル基、フマロ イル基、メサコノイル基、カンホロイル基、ベンゾイル 基、フタロイル基、イソフタロイル基、テレフタロイル 基、ナフトイル基、トルオイル基、ヒドロアトロポイル 【0077】前記シリル基としては、例えば、トリメチ 50 基、アトロポイル基、シンナモイル基、フロイル基、テ

ノイル基、ニコチノイル基、イソニコチノイル基、p-トルエンスルホニル基、メシル基等を挙げることができ る。前記環式酸解離性基としては、例えば、シクロプロ ピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロ ヘキセニル基、オキソシクロヘキセニル基、4ーメトキ シシクロヘキシル基、テトラヒドロピラニル基、テトラ ヒドロフラニル基、テトラヒドロチオピラニル基、テト ラヒドロチオフラニル基、3-ブロモテトラヒドロピラ ニル基、4-メトキシテトラヒドロピラニル基、4-メ トキシテトラヒドロチオピラニル基、S, S-ジオキシ 10 ド基、2-1、3-ジオキソラニル基、2-1、3-ジ チオラニル基、ベンゾー2-1,3-ジオキソラニル 基、ベンゾー2-1、3-ジチオラニル基等を挙げるこ とができる。

【0079】これらの酸解離性基のうち、tーブチル 基、ベンジル基、tーブトキシカルボニル基、テトラヒ ドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒド ロチオピラニル基、テトラヒドロチオフラニル基等が好 ましい。

【0080】また、溶解制御性樹脂は、例えば、酸性官 能基を有するアルカリ可溶性樹脂に1種以上の前記酸解 離性基を導入する方法、1種以上の前記酸解離性基を有 する単量体を(共)重合する方法、1種以上の前記酸解 離性基を有する重縮合成分を(共)縮合する方法等によ って製造することができる。溶解制御性樹脂における酸 解離性基の導入率(溶解制御性樹脂中の酸性官能基と酸 解離性基との合計数に対する酸解離性基の数の割合) は、好ましくは15~100%、さらに好ましくは20 ~100%、特に好ましくは20~80%である。溶解 制御性樹脂のMwは、好ましくは1,000~150. 000、さらに好ましくは3,000~100,000 である。本発明における溶解制御剤の配合量は、共重合 体(イ)100重量部当たり、100重量部以下が好ま しい。この場合、溶解制御剤の配合量が100重量部を 越えると、樹脂組成物の製膜性、膜強度等が低下する傾 向がある。本発明において、溶解制御剤は、低分子化合 物および高分子化合物(即ち、溶解制御性樹脂)それぞ れについて、単独でまたは2種以上を混合して使用する ことができ、また低分子化合物と高分子化合物とを併用 することもできる。

### 【0081】他の添加剤

さらに、本発明の感放射線性樹脂組成物には、必要に応 じて、界面活性剤、増感剤等の他の添加剤を配合するこ とができる。前記界面活性剤は、感放射線性樹脂組成物 溶液の塗布性やストリエーション、レジストの現像性等 を改良する作用を示す。このような界面活性剤として は、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポ リオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチ レンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフ ェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエ 50 ルアセテート等のエチレングリコールモノアルキルエー

ーテル、ポリオキシエチレングリコールジラウレート ポリオキシエチレングリコールジステアレートのほか、 以下商品名で、KP341 (信越化学工業 (株) 製)、 ポリフローNo. 75, No95 (共栄社油脂化学工業 (株) 製)、エフトップEF301, EF303, EF 352 (トーケムプロダクツ (株) 製) 、メガファック F171, F172, F173 (大日本インキ化学工業 (株) 製)、フロラードFC430、FC431 (住友 スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710,サー フロンS-382, SC-101, SC-102, SC -103, SC-104, SC-105, SC-106(旭硝子(株)製)等を挙げることができる。これらの 界面活性剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用す ることができる。界面活性剤の配合量は、感放射線性樹 脂組成物中の全固形分100重量部当たり、通常、2重 量部以下である。また、前記増感剤は、放射線のエネル ギーを吸収して、そのエネルギーを酸発生剤(ロ)に伝 達し、それにより酸の生成量を増加させる作用を示すも ので、本発明の感放射線性樹脂組成物を用いて得られる レジストの感度を向上させる効果を有する。増感剤の好 ましい具体例としては、アセトン、ベンゼン、アセトフ エノン類、ベンゾフェノン類、ナフタレン類、ビアセチ ル、エオシン、ローズベンガル、ピレン類、アントラセ ン類、フェノチアジン類等を挙げることができる。これ らの増感剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用す ることができる。増感剤の配合量は、感放射線性樹脂組 成物中の全固形分100重量部当たり、通常、50重量 部以下、好ましくは30重量部以下である。また、染料 あるいは顔料を配合することにより、露光時のハレーシ ョンの影響を緩和でき、接着助剤を配合することによ り、基板との接着性を改善することができる。さらに、 他の添加剤としては、アゾ化合物、アミン化合物等のハ レーション防止剤や、保存安定剤、消泡剤、形状改良剤 等を挙げることができる。

# 【0082】溶剤

30

本発明の感放射線性樹脂組成物は、その使用に際して、 固形分濃度が例えば0.5~50重量%、好ましくは 0. 5~40重量%となるように溶剤に溶解したのち、 例えば孔径 0. 2μ m程度のフィルターで濾過すること 40 によって、組成物溶液として調製される。前記組成物溶 液の調製に使用される溶剤としては、例えば、エチレン グリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモ ノエチルエーテル、エチレングリコールモノー n ープロ ピルエーテル、エチレングリコールモノーn-ブチルエ ーテル等のエチレングリコールモノアルキルエーテル 類;エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノ-n-プロピルエーテルア セテート、エチレングリコールモノー n ーブチルエーテ

テルアセテート類;ジエチレングリコールジメチルエー テル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ レングリコールジーnープロピルエーテル、ジエチレン グリコールジ-n-ブチルエーテル等のジエチレングリ コールジアルキルエーテル類;プロピレングリコールモ ノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエ ーテル、プロピレングリコールモノーn-プロピルエー テル、プロピレングリコールモノーn-ブチルエーテル 等のプロピレングリコールモノアルキルエーテル類;プ ロピレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリ 10 コールジエチルエーテル、プロピレングリコールジーn -プロピルエーテル、プロピレングリコールジ-n-ブ チルエーテル等のプロピレングリコールジアルキルエー テル類:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセ テート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセ テート、プロピレングリコールモノーn-プロピルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノーn-ブチ ルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモノア ルキルエーテルアセテート類;乳酸メチル、乳酸エチ ル、乳酸n-プロピル、乳酸イソプロピル、乳酸n-ブ 20 チル、乳酸イソブチル等の乳酸エステル類;ギ酸メチ ル、ギ酸エチル、ギ酸nープロピル、ギ酸iープロピ ル、ギ酸n-ブチル、ギ酸i-ブチル、ギ酸n-アミ ル、ギ酸iーアミル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸n ープロピル、酢酸iープロピル、酢酸nーブチル、酢酸 iーブチル、酢酸nーアミル、酢酸iーアミル、酢酸n - ヘキシル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチ ル、プロピオン酸n-プロピル、プロピオン酸i-プロ ピル、プロピオン酸 n - ブチル、プロピオン酸 i - ブチ ル、酪酸メチル、酪酸エチル、酪酸 n - プロピル、酪酸 30 i-プロピル、酪酸n-ブチル、酪酸i-ブチル等の脂 肪族カルボン酸エステル類;ヒドロキシ酢酸エチル、2 ーヒドロキシー2ーメチルプロピオン酸エチル、2ーヒ ドロキシー3-メチル酪酸メチル、メトキシ酢酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、3-メトキシプロピオン酸メ チル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシ プロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチ ル、3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシ ブチルプロピオネート、3-メチル-3-メトキシブチ 40 ルブチレート、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、 ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル等の他のエステル 類;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類;メチル エチルケトン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン、4-ヘプタノン、シクロヘキサノン等のケトン類;N-メチ ルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルアセトアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、 Nーメチルピロリドン等のアミド類; y ーブチロラクト ン等のラクトン類等を挙げることができる。これらの溶

できる。組成物溶液を調製する際の溶剤の使用量は、感放射線性樹脂組成物の全固形分100重量部当たり、通常、100~20、000重量部、好ましくは150~15、000重量部、さらに好ましくは200~10、000重量部である。

# 【0083】 レジストパターンの形成

本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを 形成する際には、該組成物の溶液を、回転塗布、流延途 布、ロール塗布等の手段によって、例えばシリコンウェ ハー、アルミニウムで被覆されたウェハー等の基板上に 塗布したのち、プレベークを行うことにより、レジスト 被膜を形成し、その後所望のパターンを形成するように 該レジスト被膜に露光する。その際に使用する放射線 は、使用する酸発生剤(ロ)の種類に応じて、i線等の 紫外線、エキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロ ン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線を適宜選択し て使用されるが、特に遠紫外線、X線、荷電粒子線が好 ましい。また、放射線量等の露光条件は、感放射線性樹 脂組成物の配合組成、添加剤の種類等に応じて、適宜選 定される。また、本発明の感放射線性樹脂組成物を用い てレジストパターンを形成する際には、作業雰囲気中に 含まれる塩基性不純物等の影響を防止するため、レジス ト被膜上に保護膜を設けることもできる。また、本発明 においては、レジスト被膜のみかけの感度を向上させる ために、露光後に焼成(ポストベーク)を行うことが好 ましい。その加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合 組成、添加剤の種類等により変わるが、通常、50~2 00°C、好ましくは80~160°Cである。次いで、ア ルカリ現像液で現像することにより、所定のレジストパ ターンを形成させる。前記アルカリ現像液としては、例 えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリ ウム、珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム、アンモニ ア水、エチルアミン、n-プロピルアミン、ジエチルア ミン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、メ チル・ジエチルアミン、ジメチル·エタノールアミン、 トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒド ロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コ リン、ピロール、ピペリジン、1、8-ジアザビシクロ [5, 4, 0] - 7 - ウンデセン、1, 5 - ジアザビ シクロー[4.3.0]-5-ノネン等のアルカリ性化 合物を、通常、1~10重量%、好ましくは2~5重量 %の濃度となるように溶解したアルカリ性水溶液が使用 される。また、前記現像液には、例えばメタノール、エ タノール等の水溶性有機溶剤や界面活性剤を適量添加す ることもできる。なお、このようにアルカリ性水溶液か らなる現像液を使用する場合には、一般に、現像後、水 で洗浄する。

# [0084]

ン等のラクトン類等を挙げることができる。これらの溶 【発明の実施の形態】以下、実施例および比較例を挙げ 剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することが 50 て、本発明をさらに具体的に説明する。但し、本発明

は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。実 施例および比較例における各種の測定・評価は、次のよ うにして行った。

#### <u>MwおよびMw/Mn</u>

東ソー (株) 製GPCカラム (G2000Hx 2本、 G3000HxL 1本、G4000HxL 1本) を用 い、流量1.0ml/分、溶出溶媒テトラヒドロフラ ン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレ ンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GPC) により測定した。

### 最適露光量

2. 38重量%のテトラヒドロアンモニウムヒドロキシ ド水溶液を用いて現像後、水洗、乾燥して、各種の基板 上にレジストパターンを形成したときの、0.25μm のライン・アンド・スペースパターン(1118)を1 対1の幅に形成する放射線の露光量を、最適露光量とし た。

#### 解像度

最適露光量で放射線を照射したときに解像されるレジス トパターンの最小寸法を、解像度とした。

### 裾引きおよび形状

各種の基板上に形成した線幅 0. 25 μ mの 1 L 1 S の 方形状断面の基板とパターンとの界面における線幅 La とパターン中間部の線幅Lbを、走査型電子顕微鏡を用 いて測定し、0.95≦La/Lb≦1.05を満足 し、パターンの壁面が垂直に近く、パターン頭部に先細 りやオーバーハングのないものを「裾引きおよび形状」 が良好であるとし、これらの条件の少なくとも1つを満 たさないものを「裾引きおよび形状」が不良であるとし た。

#### 【0085】合成例1

p - ヒドロキシスチレン30g、アクリル酸 t ーブチル 10gおよびスチレン8gをジオキサン50gに溶解 し、2,2'ーアゾビスイソブチロニトリル8.2gを 加えて、窒素ガスで30分間バブリングを行ったのち、 バブリングを継続しながら、60℃に加熱して7時間重 合を行った。重合後、反応溶液を多量のヘキサン中に注 いで重合体を凝固させて回収した。次いで、この重合体 をアセトンに溶解したのち、再度ヘキサン中に凝固させ る操作を数回繰り返して、未反応単量体を除去したの ち、重合体を50℃、減圧下で一晩乾燥して、白色の重 合体(収率55重量%)を得た。得られた重合体は、1 H-NMR分析の結果、p-ヒドロキシスチレン、アク リル酸 t ーブチルおよびスチレンの共重合組成 (重量 比)が、ほぼ3:1:1であり、Mwが24、000、

Mw/Mnが2.0であった。この重合体を、樹脂(A 1) とする。

#### 【0086】合成例2

使用する単量体を、p-ヒドロキシスチレン30g、メ タクリル酸 t - ブチル10g、スチレン8gおよびトリ プロピレングリコールジアクリレート4gに変えた以外 は、合成例1と同様にして、白色の重合体(収率45重 量%) を得た。得られた重合体は、 <sup>1</sup>H-NMR分析の 結果、p-ヒドロキシスチレン、メタクリル酸 t-ブチ ル、スチレンおよびトリプロピレングリコールジアクリ レートの共重合組成(重量比)が、ほぼ3:1:1: 0.1であり、Mwが53,000、Mw/Mnが3. 6であった。この重合体を、樹脂(A2)とする。

#### 【0087】合成例3

使用する単量体を、pーヒドロキシスチレン30gおよ びアクリル酸t-ブチル20gに変えた以外は、合成例 1と同様にして、白色の重合体(収率50重量%)を得 た。得られた重合体は、 ¹H-NMR分析の結果、p-ヒドロキシスチレンおよびアクリル酸 t ーブチルの共重 20 合組成(重量比)が、ほぼ3:2であり、Mwが22, 000、Mw/Mnが2.4であった。この重合体を、 樹脂(A3)とする。

【0088】実施例1~10および比較例1~2 樹脂(イ)、酸発生剤(ロ)、酸拡散制御剤として塩基 性化合物(ハ)または他の化合物、溶解抑制剤および溶 剤を、表1に示す配合組成(但し、部は重量に基づ く。) で混合して均一溶液としたのち、孔径 0. 2 μm のメンブランフィルターでろ過して、組成物溶液を調製 した。次いで、各組成物溶液を、表2に示す基板上にス 30 ピンコーターで塗布し、表2に示す温度で100秒間プ レベークを行って、膜厚 0. 7 μ m の レジスト被膜を形 成した。その後、表2に示す放射線により露光した。こ のとき、放射線がKFFエキシマレーザーの場合は、露 光機として (株) ニコン製Nikon NSR2005 EX8A (開口数0.5) を用い、また放射線が電子 線の場合は、電子線描画装置として(株)日立製作所製 Hitachi HL700D (但し、加速電圧を50 KeVに改造したもの)を用いた。その後、表2に示す 温度で120秒間、ポストベークを行った。その後、 2. 38重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド 水溶液を用い、23℃で1分間浸漬法により現像したの ち、水で30秒間洗浄した。各レジストの評価結果を、

表2に示す。 [0089]

【表1】

40

### 表\_1\_

	共重合体(イ) または 他の酸解離性		酸発生剤(口)		塩基性化合物(ハ)		溶解制御剤	溶剤	
	基含	(部)		(部)	_	(部)	(部)		(部)
実施例1	A 1	(100)	B 1	(4)	C 1	(0.2)	D1 (10)	EL	(550)
実施例2	A 1	(100)	B 1 B 2	(2) (2)	C 2	(0, 2)		EL EEP	(390) (160)
実施例3	ΑI	(100)	B 2	(4)	C 3	(0, 2)		E L POMEA	(390) (160)
実施例4	A 1	(100)	В 3	(5)	C 4	(0, 2)		EL	(550)
実施例5	A 1	(100)	B 2 B 3	(2) (2)	C 5	(0, 2)	<del></del>	EL EEP	(390) (160)
実施例6	A 2	(100)	B 1	(4)	C 6 C10	(0, 1) (0, 1)		E L POMBA	(390) (160)
実施例7	A 3	(100)	B 1	(1)	C 7	(0, 05)		E L POMEA	(390) (160)
実施例8	A l a l	(80) (20)	Ві	(4)	C 8	(0, 2)		MAK	(550)
実施例9	A 3	(100)	В 1	(4)	<b>C</b> 9	(0, 2)		E L MMP	(390) (160)
実施例10	A 3	(100)	<b>B</b> 1	(10)	C 7	(0, 4)		EL	(550)
比較例1	A 1	(100)	B 1	(4)	c 1	(0, 2)	D1 (10)	EL	(550)
比較例2	A 4	(100)	В 2	(4)	c 2	(0, 2)	<del></del>	EL	(550)

【0090】表1中の各成分は、次のとおりである。 共重合体(イ)

A 1 ~ A 3 : 合成例 1 ~ 3 参照

### 他の酸解離性基含有樹脂

a 1 : ポリ (p-ヒドロキシスチレン) 中のフェノ ール性水酸基の水素原子の30モル%が1-エトキシエ 30 ーヒドロキシプロピル)ジエチレントリアミン チル基で置換された樹脂 (Mw=9, 000)

### 酸発生剤 (ロ)

B1:  $\forall X$  (4-t-7)  $\forall F$  (4-t-7)  $\forall F$  (4-t-7)ムパーフルオロブタンスルホネート

B2 : ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウ ムー10ーカンファースルホネート :

B3 : トリフェニルスルホニウムンパーフルオロブ タンスルホネート

### 酸拡散制御剤

### 塩基性化合物(ハ)

CI: トリエタノールアミン

C2: N- (2-ヒドロキシエチル) ピペリジン

C3: 1, 3-ビス (ジメチルアミノ) -2-プロパ

ノール

C4: N, N'-ビス (2-ヒドロキシエチル) ピペ ・ラジン

C5: 1,  $2-\forall \lambda$  [4' - {N-(2''- $\forall \lambda$ ) - シエチル) ピペリジニル} ] プロパン

C6 : N, N, N', N'-テトラキス (2-ヒド ロキシエチル) エチレンジアミン

ロキシプロピル) エチレンジアミン

C8: N, N, N', N'', N'' -ペンタキス (2)

フェノール

C10 : α-ピリドイン

### 他の化合物

c1 : トリーn-ブチルアミン c2 : N, N-ジメチルアニリン

#### 溶解制御剤

D1 : 前記構造式 (13) で表される化合物

# 溶剤

40 E L : 乳酸エチル

> EEP : 3-エトキシプロピオン酸エチル MMP : 3-メトキシプロピオン酸メチル

PGMEA : プロピレングリコールモノメチルエーテル

アセテート

MAK : メチルーn-アミルケトン

[0091]

【表2】

### \_ 表 2

	基板	放射線	ベーク温度(℃)		最適露光量	解像度	据]き および
			プレベ ーク	ポスト ベーク	IE.		形状
実施例1	SiON	KrF(#1)	130	130	30 (*1)	0, 20	良好
実施例 2	SiN	KrF(*1)	130	130	36 (‡1)	0. 20	良好
実施例3	SiON	KrF(#1)	130	130	33 (‡1)	0, 20	良好
実施例4	TiN	KrF(*1)	130	130	35 (*1)	0. 20	良好
実施例 5	SiON	KrF(*1)	130	130	32 (‡1)	0, 20	良好
実施例6	SiON	KrF(*1)	90	90	45 (‡1)	0. 20	良好
実施例7	SiN	KrF(*1)	130	130	36 (‡1)	0, 20	良好
実施例8	TiN	KrF(*1)	130	130	35 (‡1)	0, 20	良好
実施例9	SiON	KrF(*1)	130	130	37 (‡1)	0, 20	良好
実施例10	SiON	電子線(#2)	130	130	8 (‡2)	0, 15	良好
比較例1	SiN	K r F(‡1)	130	130	28 (‡1)	0, 23	不良 裾引きが大
比較例2	SiON	K r F(‡1)	130	130	34 (‡1)	0. 23	不良 裾引きが大

(‡1) KrFはKrFエキシマレーザーで、露光量単位はmJ/cm2。

(#2) 電子線はビーム径が $0.25\mu m$ で、露光量単位は $\mu C/cm^2$ 。

# [0092]

\*バーハングのない矩形のパターンを形成することができる。さらに、本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に遠紫外線、X線あるいは電子線に対して、感度、解像度等にも優れている。したがって、本発明の感放射線性樹脂組成物は、今後ますます微細化が進行するとみられる半導体デバイスの製造用レジストとして極めて好適に使用することができる

フロントページの続き

(72) 発明者 岩永 伸一郎

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AB16 AC04

AC05 AC06 AC08 AD03 BC81

BE00 BE01 BE07 BE10 CB06

CB14 CB17 CB41 CB43 CB45

CC20 FA07 FA12 FA17